

# 元器件生产厂商自查承诺书

依据ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件ZZKK评估通用准则》和ZKB 3101-002-2022《WQZB使用国产电子元器件“W、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求,我单位针对研制生产的电子元器件产品开展ZZKK等级和“W、空、包”情况自查及评估。结果如下:

自查产品共27项,其中ZZKKA级0项、B级27项、C级0项、C\*级0项、D级0项、E级0项;W国产化0项、BZ国产化0项、KX国产化0项。

电子元器件“W、空、包”审查基本信息填写表详见附表1;

电子元器件使用IP核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表2。

我单位承诺以上内容真实有效,自愿承担一切后果。

特此承诺。

无锡泰连芯科技有限公司(盖章)

2026年01月12日



附表 1 电子元器件“W、空、包”审查信息一览表

| 序号 | 一级分类    | 二级分类 | 三级分类 | 元器件名称   | 型号规格             | 生产厂商        | ZZKK等级 | 是否“W 国产化” |      | 是否“BZ 国产化” |      | 是否“KX 国产化” |      | 备注 |
|----|---------|------|------|---------|------------------|-------------|--------|-----------|------|------------|------|------------|------|----|
|    |         |      |      |         |                  |             |        | 是/否       | 情况说明 | 是/否        | 情况说明 | 是/否        | 情况说明 |    |
| 1  | 半导体集成电路 | 放大器件 | /    | 电流检测放大器 | JTLXA240LC50IC8  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B      | 否         | 无    | 否          | 无    | 否          | 无    |    |
| 2  | 半导体集成电路 | 放大器件 | /    | 电流检测放大器 | JTLXA240MC50IC8  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B      | 否         | 无    | 否          | 无    | 否          | 无    |    |
| 3  | 半导体集成电路 | 放大器件 | /    | 电流检测放大器 | JTLXA240NC50IC8  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B      | 否         | 无    | 否          | 无    | 否          | 无    |    |
| 4  | 半导体集成电路 | 放大器件 | /    | 电流检测放大器 | JTLXA240LCTSSOP8 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B      | 否         | 无    | 否          | 无    | 否          | 无    |    |
| 5  | 半导体集成电路 | 放大器件 | /    | 电流检测放大器 | JTLXA240MCTSSOP8 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B      | 否         | 无    | 否          | 无    | 否          | 无    |    |
| 6  | 半导体集成电路 | 放大器件 | /    | 电流检测放大器 | JTLXA240NCTSSOP8 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B      | 否         | 无    | 否          | 无    | 否          | 无    |    |

|    |         |      |   |         |                     |             |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---------|------|---|---------|---------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 7  | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240LCMSOP8     | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 8  | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240MCMSOP8     | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 9  | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240NCMSOP8     | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 10 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240LCSOIC8(W)  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 11 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240MCSOIC8(W)  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 12 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240NCSOIC8(W)  | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 13 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240LCTSSOP8(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 14 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240MCTSSOP8(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 15 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240NCTSSOP8(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |

|    |         |      |   |         |                    |             |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---------|------|---|---------|--------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 16 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240LCMSOP8(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 17 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240MCMSOP8(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 18 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240NCMSOP8(W) | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 19 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240LC8SOIC8    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 20 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240MC8SOIC8    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 21 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240NC8SOIC8    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 22 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240LCTSSOP8    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 23 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240MCTSSOP8    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 24 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240NCTSSOP8    | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |

|    |         |      |   |         |                |             |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---------|------|---|---------|----------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 25 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240LCMSOP8 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 26 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240MCMSOP8 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |
| 27 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240NCMSOP8 | 无锡泰连芯科技有限公司 | B | 否 | 无 | 否 | 无 | 否 | 无 |  |

填报单位(鉴章): 法定代表人(鉴章): 汤学明 填表人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20260112

填表说明:

1. 一级、二级、三级分类按ZKB3101-002附录A填写
2. 元器件名称: 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
3. 型号规格: 应填写元器件完整型号规格;
4. 生产厂商: 应填写元器件生产厂商中文全称, 勿填写代理商;
5. Wkb: 按照ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件ZZKK评估通用准则》执行, 分为A、B、C、C\*、D、E六个等级, 针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照GJB 9530执行;
6. “Wkb”应按照ZKB3101-002-2022标准执行。若为“是”时, 则需要在“情况说明”写明判别因素; 若为“否”时, 则填“无”;
7. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。

附表 2 电子元器件基本信息表

| 序号 | 一级分类    | 二级分类 | 三级分类 | 元器件名称   | 型号规格             | 使用 IP 核情况 |    |      |       | 原材料和零部件 |         |      |       | 流片工艺”     |       | 备注 |
|----|---------|------|------|---------|------------------|-----------|----|------|-------|---------|---------|------|-------|-----------|-------|----|
|    |         |      |      |         |                  | 名称        | 类型 | 来源单位 | 境内/境外 | 名称      | 是否核心/关键 | 来源单位 | 境内/境外 | 工艺名称      | 境内/境外 |    |
| 1  | 半导体集成电路 | 放大器件 | /    | 电流检测放大器 | JTLXA240LC SOIC8 | IP 核 1    | /  | /    | /     | 流片      | 关键      | 台积电  | 境内    | BCD 180nm | 境内    |    |
|    |         |      |      |         |                  | IP 核 2    | /  | /    | /     | 封装      | /       | 长电宿迁 |       |           |       |    |
| 2  | 半导体集成电路 | 放大器件 | /    | 电流检测放大器 | JTLXA240MC SOIC8 | IP 核 1    | /  | /    | /     | 流片      | 关键      | 台积电  | 境内    | BCD 180nm | 境内    |    |
|    |         |      |      |         |                  | IP 核 2    | /  | /    | /     | 封装      | /       | 长电宿迁 |       |           |       |    |
| 3  | 半导体集成电路 | 放大器件 | /    | 电流检测放大器 | JTLXA240NC SOIC8 | IP 核 1    | /  | /    | /     | 流片      | 关键      | 台积电  | 境内    | BCD 180nm | 境内    |    |
|    |         |      |      |         |                  | IP 核 2    | /  | /    | /     | 封装      | /       | 长电宿迁 |       |           |       |    |
| 4  | 半导体集成电路 | 放大器件 | /    | 电流检测放大器 | JTLXA240LCTSSOP8 | IP 核 1    | /  | /    | /     | 流片      | 关键      | 台积电  | 境内    | BCD 180nm | 境内    |    |
|    |         |      |      |         |                  | IP 核 2    | /  | /    | /     | 封装      | /       | 长电宿迁 |       |           |       |    |

|    |         |      |   |         |                     |        |   |   |   |    |    |      |    |           |    |  |
|----|---------|------|---|---------|---------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|-----------|----|--|
| 5  | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240MCTSSOP8    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 6  | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240NCTSSOP8    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 7  | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240LCMSOP8     | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 8  | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240MCMSOP8     | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 9  | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240NCMSOP8     | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 10 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240LC SOIC8(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |

|    |         |      |   |         |                     |        |   |   |   |    |    |      |    |           |    |  |
|----|---------|------|---|---------|---------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|-----------|----|--|
| 11 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240MCSOIC8(W)  | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 12 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240NCSOIC8(W)  | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 13 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240LCTSSOP8(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 14 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240MCTSSOP8(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 15 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240NCTSSOP8(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 16 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240LCMSOP8(W)  | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                     | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |



|    |         |      |   |         |                    |        |   |   |   |    |    |      |    |           |    |  |
|----|---------|------|---|---------|--------------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|-----------|----|--|
| 17 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240MCMSOP8(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 18 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | JTLXA240NCMSOP8(W) | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 19 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240LC SOIC8    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 20 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240MC SOIC8    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 21 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240NC SOIC8    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 22 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240LCTSSOP8    | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                    | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |

|    |         |      |   |         |                 |        |   |   |   |    |    |      |    |           |    |  |
|----|---------|------|---|---------|-----------------|--------|---|---|---|----|----|------|----|-----------|----|--|
| 23 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240MCTSSOP8 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 24 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240NCTSSOP8 | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 25 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240LCMSOP8  | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 26 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240MCMSOP8  | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |
| 27 | 半导体集成电路 | 放大器件 | / | 电流检测放大器 | TLXA240NCMSOP8  | IP 核 1 | / | / | / | 流片 | 关键 | 台积电  | 境内 | BCD 180nm | 境内 |  |
|    |         |      |   |         |                 | IP 核 2 | / | / | / | 封装 | /  | 长电宿迁 |    |           |    |  |



填报单位(盖章): 法定代表人(鉴章): 邵学明 填报人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20260112

填表说明:

1. 一级、二级、三级分类按ZKB3101-002 附录A填写
2. 元器件名称: 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
3. 型号规格: 应填写元器件完整型号规格;
4. 使用IP 核情况: 仅适用于半导体集成电路, 应填写IP 核类型, 包括“软核”“固核”“硬核”;
5. 原材料和零部件: 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写, 至少包含ZKB 3101-002-2022 标准附录A中零部件或原材料, 同时也应包含外壳、引出端、键合丝等, 不包含灌封料等生产过程材料;
6. 是否“核心”/“关键”: 应根据ZKB 3101-002-2022 标准附录A 填写“核心”或“关键”, 非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填;
7. 来源单位: 应根据实际设计单位或生产商情况填写, 不能按代理商填写; 对来源不明的, 应填写“来源不明”, 具体判定时视为“境外”;
8. 流片工艺: 仅适用于半导体集成电路, 应填写流片工艺名称, 如45nmBCD 工艺等;
9. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。